

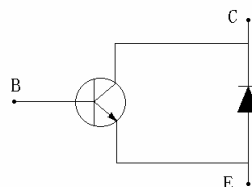
11005

硅 NPN 高压开关晶体管芯片 (4")

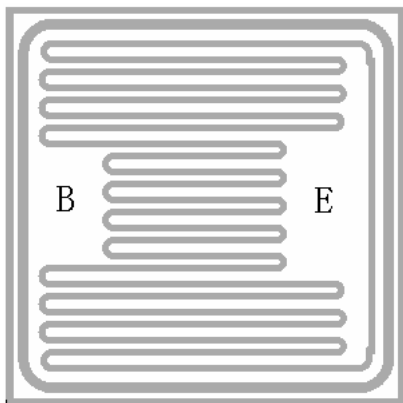
■ 用途

主要用于 110V 节能灯、日光灯电子镇流器及其它开关、振荡电路。

■ 内部结构



■ 芯片示意图



■ 芯片结构

芯片尺寸	2000μm×2000μm
压焊区尺寸	基区 360μm×586μm 发射区 400μm×745μm
芯片厚度	240±10μm
锯片槽宽度	80μm
金属层	正面: Al 3.5±0.4μm 背面: Ag 1.4±0.2μm

■ 电特性(T_a=25℃)

参数名称	符号	测试条件	最小值	最大值	单位
集电极-基极截止电流	I _{CB0}	V _{CB} =350V		1	μA
发射极-基极截止电流	I _{EB0}	V _{EB} =9V		5	μA
集电极-基极击穿电压	BV _{CB0}	I _C =0.1mA	350		V
集电极-发射极击穿电压	BV _{CEO}	I _C =1mA	220		V
发射极-基极击穿电压	BV _{EB0}	I _E =0.1mA	9		V
直流电流增益	h _{FE}	V _{CE} =5V, I _C =500mA	10	40	
集电极-发射极饱和电压	V _{CE(sat)}	I _C =500mA, I _B =100mA		0.5	V
基极-发射极饱和电压	V _{BE(sat)}	I _C =500mA, I _B =100mA		1	V
特征频率	f _T	V _{CE} =10V, I _C =200mA	5		MHz

* 该产品有保护二极管